LABORATÓRIO 2 - SIMULAÇÃO SPICE DO INVERSOR

Revisão: 21/março/2023 Fernando Moraes

```
Login na máquina com o software de simulação:
    ssh -X <user>@kriti.inf.pucrs.br -p 8888

Se necessário, configurar o ambiente para a simulação:
    source /soft64/source_gaph; module load ic mmsim

Baixar os arquivos com o comando:
    wget http://www.inf.pucrs.br/~moraes/microel/lab2/lab2.zip --no-check-certificate
    unzip lab2.zip; cd lab2
```

O objetivo deste laboratório é realizar 6 simulações com o inversor:

- 1. Curva DC (1 pt)
- 4. Efeito da rampa de entrada (2 pts)
- 2. Dimensionamento (2 pts)
- 5. Efeito de regeneração de nível lógico no inversor (1 pt)
- 3. Carga na Saída (3 pts)
- 6. Oscilador em Anel (1 pt)

Os seguintes arquivos são utilizados:

O arquivo inv.sp é o principal arquivo utilizado neste laboratório, pois descreve o inversor e a respectiva tecnologia. Este arquivo é empregado em todas as simulações deste laboratório. Observar que o dimensionamento N e P são dados pelas variáveis wp e wn, as quais são definidas nos arquivos que instanciam o inv.sp.

```
simulator lang=spectre insensitive=no
include "st65.scs"
simulator lang=spice

* descrição do inversor na forma de um subcircuito
*
.subckt inv in out vcc
M1 out in vcc vcc psvtgp w=wp 1=0.06
M2 out in 0 0 nsvtgp w=wn 1=0.06
.ends inv

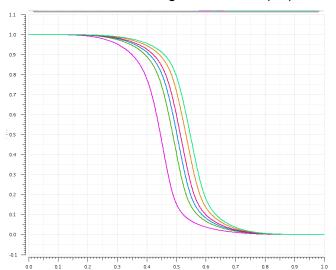
vcc vcc 0 dc 1.0
```

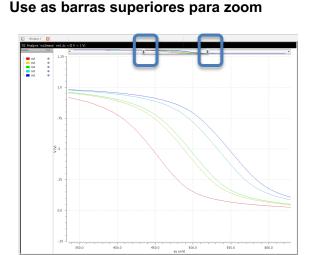
Os arquivos com sufixo .sp contêm a descrição spice do circuito, enquanto que o arquivo st65.scs define a tecnologia que iremos empregar (65 nm). O arquivo de tecnologia deve estar no mesmo diretório do arquivo contendo a descrição spice.

1) SIMULAÇÃO DC DE UM INVERSOR (1 ponto)

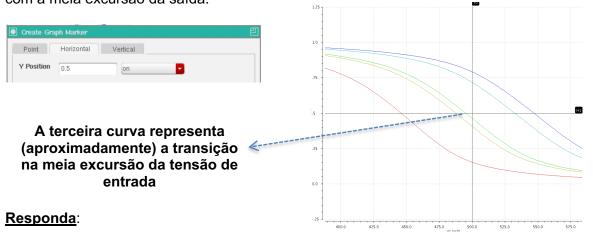
Simular o arquivo <u>inv0 dc.sp</u> (spectre e viva). Esta é uma simulação DC, em que se plota a tensão de entrada (v(iv), eixo x) versus a tensão de saída de saída (v(out), eixo y). Neste arquivo mantém-se Wn=0,2 μm e Wp varia de 0,2 μm a 1,0 μm.

- A descrição do circuito compreende um inversor conectado à uma capacitância de 5fF:
 X1 iv out vcc inv
 C1 out 0 5fF
- Na interface gráfica para cada simulação dc plotar o v(out) para cada valor de Wp (Wn constante, sendo igual a Wn=0.2 μm)





Usar o menu "Marker" e nele "Create Marker", criando 2 marcadores, um vertical e outro horizontal, em 0.5 (0.5V). A interseção dos marcadores corresponde à meia excursão da entrada com a meia excursão da saída.



- 1.1. [0,5pt] No relatório apresentar os gráficos de simulação como acima, **inserindo labels** sobre as mesmas indicando o dimensionamento Wp (por exemplo, 0.2). Explique o comportamento das curvas. Porque ocorre o deslocamento das curvas para a direita com o aumento do Wp?
- 1.2. [0,5pt] Qual o valor da relação Wp/Wn na figura onde se ilustra o ponto onde ocorre a transição da entrada e saída na meia excursão da alimentação? O que esta relação indica?

2) SIMULAÇÃO DE UM INVERSOR PARA DIFERENTES DIMENSIONAMENTOS DE TRANSISTOR (2 pontos)

Simular o arquivo: <u>inv1 w.sp</u>. Nesta simulação avalia-se o atraso de um inversor em função do dimensionamento dos transistores, variando-se o Wp de 0.2 a 1.0 μm (Wn é constante e igual a 0.2 μm). **Plotar v(out) em relação ao tempo**:

Observar no arquivo spice os comandos de medida:

```
* mede os tempos de propagacao
.measure tran pHL trig v(iv) val=0.5 td=5n rise = 1
+ targ v(out) val=0.5 fall = 1
```

```
.measure tran pLH trig v(iv) val=0.5 td=5n fall = 1
+ targ v(out) val=0.5 rise = 1
.measure tran TD param = 'pHL * 1e12'
.measure tran TS param = 'pLH * 1e12'
```

Nestes comandos estamos medindo os tempos de propagação para descida (**TD**) e subida (**TS**), em picosegundos (10⁻¹²)

```
O resultado é dado no arquivo inv1 w.measure (repetido 7 vezes, 7 wp diferentes):
                   Measurement Name
                                           transient1
                   Analysis Type
                                        •
                                           tran
                   diff
                                     = -18.7878
                   phl
                                     = 2.15172e-11
                   plh
                                     = 4.03049e-11
                                     = 21.5172
                   td
                                                      Tempo em pisosegundo
                                     = 40.3049
                   ts
                                                  1.25
```

Plote na parte superior da simulação v(iv) (entrada), e na parte inferior as 7 curvas v(out) (saída). É uma interface gráfica padrão, só arrastar o nome da forma de onda para onde se deseja coloca-la.

Pede-se:

- 2.1. [0,25pt] Apresentar no relatório as formas de onda como apresentado na figura da direita, colocando label wp=xx na curva com menor inclinação e wp=yy na curva com maior inclinação (como indicado xx e yy devem corresponder ao valor de W)
- 2.2. [0,25pt] Fazer uma tabela para os tempos de propagação de subida e descida (arredondar para duas casas decimais). Os dados dos comandos de medida estão no arquivo inv1_w.measure. A coluna |TD-TS| corresponde à medida diff no arquivo measure, e deve ser apresentado o valor absoluto (módulo)

Dimensão Wp (microns)	T. Descida (ps)	T. Subida (ps)	TD-TS
0,2			
0,4			
0,45			
0,5			
0,6			
0,8			
1,0			

2.3. [0,5pt] Notar que apesar do transistor N manter a mesma dimensão (0.2 μm), o tempo de propagação de descida (TD) aumentou com o aumento do transistor P. Pesquisar a razão e explicar.

- 2.4. [0,5pt] Fazer um gráfico para TD e TS. O gráfico terá duas curvas, no eixo X os dimensionamentos do transistor P (0,2, 0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0), e no eixo y os tempos TD e TS. Cuidar a escala do eixo X!
- 2.5. [0,5pt] Sendo wn=0.2 μm, para qual tamanho de Wp/Wn os tempos de subida e descida igualam-se (ou possuem a menor |TD-TS|)? Comparar com a primeira simulação e discutir. Mostrar este ponto no gráfico da questão 2.4.

3) SIMULAÇÃO DE UM INVERSOR PARA DIFERENTES CONDIÇÕES DE CARGA (3 pontos)

- Simular o arquivo: inv2 load.sp. Nesta simulação:
 - avalia-se o atraso do inversor em função da carga de saída, variando-se o Cl de 1fF a 50 fF.
 - o observa-se a corrente consumida durante o chaveamento (mesmo artifício empregado na descrição spice, fonte de tensão nula com medida de corrente sobre a mesma):

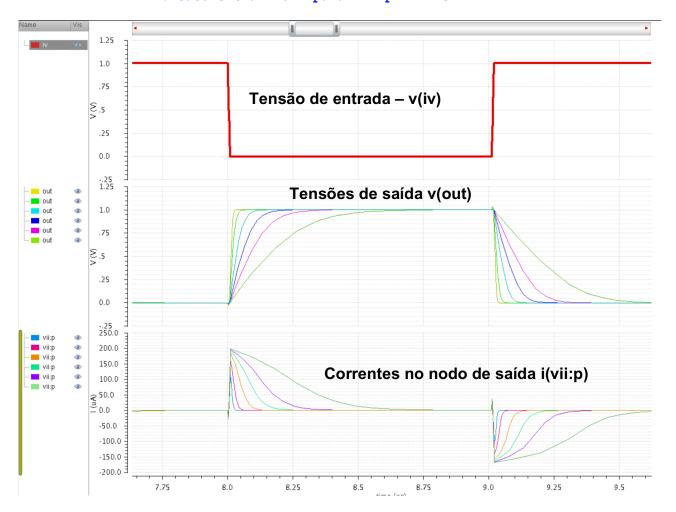
```
X1 iv out vcc inv vii out out2
C3 out2 0 cl
```

 Notar que neste circuito estamos medindo também a potência média consumida pelo circuito:

```
.measure cons_medio AVG POWER FROM=0n TO=25n
```

 Os comandos de medida no arquivo de simulação já fornecem o atraso em ps e a dissipação de potência em microwatt:

```
.measure tran POT param = 'cons_medio * 1e6'
.measure tran TD param = 'pHL * 1e12'
.measure tran TS param = 'pLH * 1e12'
```



• A capacitância de entrada de um inversor com Wn=0.2 μm e Wp=0.5 μm é dada por:

$$C_{gate} = C_{ox} * (W_p + W_n) * L = 18,367 * (0,2 + 0,5) * 0,06 = 0,77 \text{ fF}$$

Onde:

- ε_{ox} : permissividade elétrica do óxido de silício 34,53*10⁻¹² F/m
- t_{ox} : espessura da junção do gate -1,88*10⁻⁹ m
- Capacitância do óxido de silício $C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{34,53*10^{-12}}{1,88*10^{-9}} = 0,018367 \frac{F}{m^2} = 18,367 \frac{fF}{\mu m^2}$

Pede-se:

- 3.1. [0,5pt] Plotar a tensão de entrada (v(iv)), as tensões de saída (V(out)), e as correntes (i(vii)), como acima. Nas curvas de tensão e corrente indicar a carga de saída utilizando labels.
- 3.2. [0,5pt] Fazer uma tabela para os tempos de subida e descida, potência média consumida e o fanout equivalente. Os dados de medida são obtidos no arquivo inv2 load.measure.
 - O fanout equivalente é obtido dividindo-se a carga de saída (C_i) pela capacitância do inversor (C_{gate}).

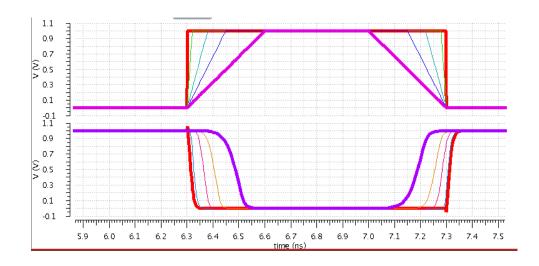
Carga de Saída (fF)	TD (em ps)	TS (em ps)	Power (em μW)	Fanout equivalente
1				
3				
8				
15				
25				
50				

- 3.3. [0,5pt] Trace um gráfico com a evolução dos tempos de subida e descida em função da carga de saída. A evolução do atraso é <u>linear</u> com a variação da carga?
- 3.4. [0,5pt] Trace um gráfico com a evolução do consumo de potência em função da carga de saída. A evolução do consumo de potência é <u>linear</u> com a variação da carga?
- 3.5. [0,5pt] Porque a energia consumida por uma porta lógica CMOS aumenta com o aumento da carga de saída? Utilizar como referência a curva de corrente obtida na simulação.
- 3.6. [0,5pt] Qual a corrente do inversor quando o mesmo não está mudando de estado? Passe o mouse sobre a curva de corrente para obter o valor de corrente quando não há transição de estado. **Qual a origem desta corrente?**

(4) SIMULAÇÃO DE UM INVERSOR COM DIFERENTES RAMPAS DE ENTRADA (2 pontos)

Simular o arquivo <u>inv3 rampa.sp</u>. Nesta simulação, ao contrário das anteriores, gera-se apenas um arquivo de saída. Não há o comando *alter* na descrição. As curvas abaixo ilustram o efeito da rampa de entrada na saída do inversor. Na parte superior temos v(i1) a v(i5) e na parte inferior v(o1) a v(o5).

Pede-se:



- 4.1. [0,5pt] Plotar as tensões de entrada (vin1 a vin5) e as tensões de saída (o1 a o5), como acima. No *plot* indicar para cada curva qual a inclinação das rampas de entrada (em *ps*) utilizando *labels*. Para determinar a rampa de entrada analisar os comandos *pulse* nas linhas 12 a 23 do arquivo spice.
- 4.2. [0,5pt] Fazer uma **tabela** para os diferentes tempos de subida e descida, conforme os exercícios anteriores. Usar como parâmetro a inclinação da entrada. Preencher a coluna 'rampa' a partir dos comandos *pulse*.

Rampa (ps)	TD (em ps)	TS (em ps)

- 4.3. [1,0pt] Fazer um resumo explicando a influência no atraso no inversor dos seguintes parâmetros:
 - a. influência do tamanho do transistor
 - b. da carga
 - c. da rampa no atraso do inversor

Pesquise (e apresente) as equações de atraso do inversor e procure comparar as equações com o obtido na simulação.

(5) SIMULAÇÃO DE INVERSORES EM SÉRIE (1 ponto)

- Simular o arquivo inv4 serie.sp.
- O arquivo spice contém 5 inversores em série:

```
X1 i a vcc inv

X2 a b vcc inv

X3 b c vcc inv

X4 c d vcc inv

X5 d e vcc inv

c1 d 0 15fF
```

O plot abaixo (próxima página) ilustra a entrada do circuito (V(i)) e a saída dos inversores X1 (v(a)), X2 (v(b)) e X3 (v(c)). A entrada v(i) excursiona apenas entre 0,49 e 0,51 V:

```
vin i 0 pulse (na nb 0 0.02N 0.02N 1N 2N) .param na=0.49 nb=0.51
```

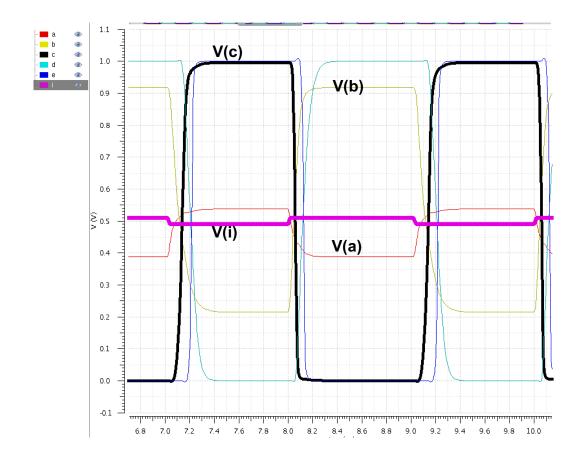
A saída do primeiro inversor (X1), no sinal 'a', provê uma excursão entre (0,39/0,54). Em X2 temos (0,21/0,92). Na saída de X3 (V(c)) já temos os níveis lógicos completamente restaurados. Esta simulação mostra a capacidade de regeneração dos níveis lógicos pelo inversor.

Pede-se:

5.1. [0,5pt] Defina a excursão mínima do sinal de entrada para que ao final de 2 inversores (v(b)) o sinal esteja restaurado (tem de ser de forma empírica, aumentar gradualmente a excursão do sinal de entrada em vin com passo de 0.005 volts – 5 mV). Apresentar uma curva para cada teste, inserindo em cada curva os valores de excursão em v(i), v(a), v(vb).

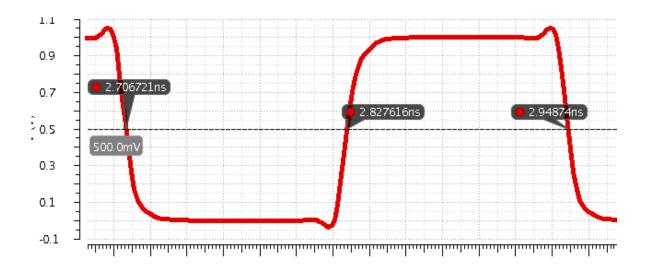
Critério para regeneração do sinal: 0: menor que 0,05V (50 mV) 1: maior que 0,95V (950 mV)

5.2. [0,5pt] Por deve-se aumentar a excursão do sinal para ocorrer a regeneração dos níveis lógicos?



(6) SIMULAÇÃO DE UM ANEL DE INVERSORES (1 ponto)

<u>COMPLETAR</u> o arquivo inv5_anel_parcial.sp, de forma que o mesmo venha a ter 15 inversores em série. O objetivo desta simulação é determinar o período de oscilação dos inversores em anel. O resultado obtido, graficamente, para o sinal de saída do último inversor está desenhado abaixo. Pelos *labels* obtidos temos o período igual a 0,242019 ns (2,94874 − 2,706721) (usei *marker* → *create marker* → *horizontal marker* em 0.5 volts), correspondendo a uma frequência de 4,13 GHz.



Dois métodos de medida são utilizados. O primeiro utiliza os tempos de subida e descida dos inversores:

```
.measure tran tf trig v(n) val=0.5 td=1n rise = 10 + targ v(o) val=0.5 fall = 10 .measure tran tr trig v(n) val=0.5 td=1n fall = 10 + targ v(o) val=0.5 td=1n fall = 10 .measure tran periodo param = '(tf+tr) * 1e9 * 15' .measure tran freq param = '1/periodo'
```

O segundo método mede a onda de saída apenas, entre 2 subidas em v(o):

```
.measure tran periodo_o trig v(o) val=0.5 td=1n rise = 2
+ targ v(o) val=0.5 rise = 3
```

No arquivo de medida (inv5 anel.measure) obtém-se:

Estas medidas correspondem a um tempo de propagação na descida igual a 8,18 ps e na subida 7,95 ps. Assim, o período de oscilação corresponde a 242 ps, o que confere com os dois comandos *measure* (período e período_o), mostrando que os dois métodos de medida são equivalentes.

Pede-se:

6.1. [1,0pt] Utilizando o comando .alter, modificar o wp do tamanho original até 50 μm (0.45, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50) - o Wn é função do Wp. Plotar um gráfico tendo como eixo x o dimensionamento de wp e no eixo y a frequência obtida. É possível chegar com 15 estágios em 5 GHz? Argumente a sua resposta.

```
.param wp=0.45 wn='wp/2.25'
.alter
.param wp=1 wn='wp/2.25'
.alter
```

FIM DO LABORATÓRIO 2